【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年2月12日(2010.2.12)

【公開番号】特開2008-187131(P2008-187131A)
【公開日】平成20年8月14日(2008.8.14)
【年通号数】公開・登録公報2008-032
【出願番号】特願2007-21485(P2007-21485)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　23/36　　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/60　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　23/36　　Ｄ
Ｈ０１Ｌ　21/60　　３１１Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月18日(2009.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
また、体積抵抗率（電気抵抗率）を10^{-1}Ω・ｃｍ以下とすると、電磁シールド効果を高めることができる。放熱体をはみ出さないように貫通孔を設けると、貫通孔の全周で封止樹脂を放熱体に接続して半導体の熱を封止樹脂を介して確実に放熱体に逃がすことができる。絶縁基板の表面の導体パターンに接続してフリップチップ実装し、絶縁基板上に半導体を搭載すると、貫通孔に注入した封止樹脂により半導体と導体パターンの接続部を直ちに被って半導体の樹脂封止を容易とすることができる。